



中国科学院科学出版基金资助出版

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 18 卷 第 4 期 1997 年 4 月

目 次

| | | |
|--|--|-------|
| HgCdTe 材料汞空位浓度的计算 | 杨建荣 | (241) |
| 高纯外延 GaAs 中浅施主杂质的光热电离谱研究 | 钱家骏 陈涌海 孙明方 王占国 林兰英 | (246) |
| MOCVD GaInP 材料生长过程热力学及其特性 | 余庆选 励翠云 彭瑞伍 | (253) |
| Fe 掺杂 $Hg_{1-x}Cd_xTe$ 材料的光谱与电学研究 | 常 勇 褚君浩 唐文国 沈文忠 汤定元 叶润清 | (258) |
| Si(111)衬底上 IBE 法外延生长 $\beta\text{-FeSi}_2$ 薄膜的研究 | 李 慧 马 辉 丁维清 秦复光 | (264) |
| 快速热氮化超薄 SiO_2 膜的氮分布和氮化机理的研究 | 冯文修 陈蒲生 黄世平 | (269) |
| CO_2 离化团束对 Si 基板表面的辐照效应 | 田民波 山田公 | (275) |
| 蝶形电极结构载流子注入全内反射交叉脊形光波导开关 | 李宝军 刘恩科 | (281) |
| 超高电流增益多晶硅发射极 BICFET 的研制与特性 | 郭维廉 宋玉兴 M. A. Green M. K. Morvvej-Farshi | (286) |
| 缓变基区对 HBT 性能的影响 | 张玉明 张义门 | (292) |
| 注 F MOS 器件的可靠性研究 | 张国强 陆 妍 范 隆 余学锋 郭 旗 任迪远 严荣良 | (297) |
| 双向 S 型负阻器件的二维数值模拟方法及模拟结果分析 | 张富斌 李建军 魏希文 | (302) |
| 多晶硅发射极晶体管的集电区补偿注入技术 | 何美华 张利春 王阳元 | (308) |

研究快报

| | | |
|--|--|-------|
| AlInGaAs/AlGaAs Strained Quantum Well Lasers Grown by Molecular Beam Epitaxy | Yang Guowen(杨国文), Xu Zuntu(徐遵图), Xu Junying(徐俊英), Zhang Jingming(张敬明), Xiao Jianwei(肖建伟) and Chen Lianghui(陈良惠) | (313) |
| Si(111)碳化层中的 SiC 结晶 | 雷天民 陈治明 马剑平 余明斌 | (317) |